

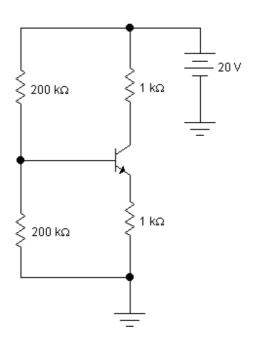
Prova de Eletrônica P₂ Terceiro Período – 2009/2 Professor: Adriano Martins Moutinho

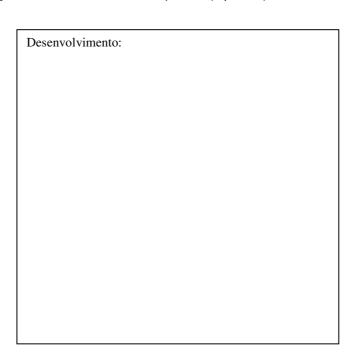
Nota:	

PERMITIDO USO DE CALCULADORA E PROVA A LAPIS. SEM CONSULTA!

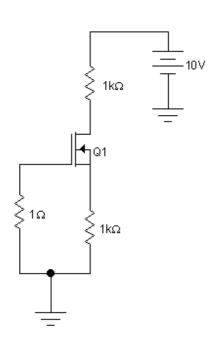
Nome:	Turma:	

1) Para o circuito abaixo, calcule o ponto de operação. Considere V_{BE} = 0.6V e β =250. (2 pontos)



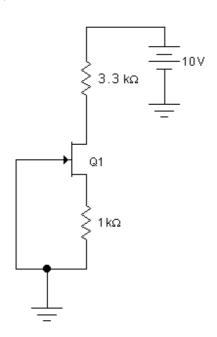


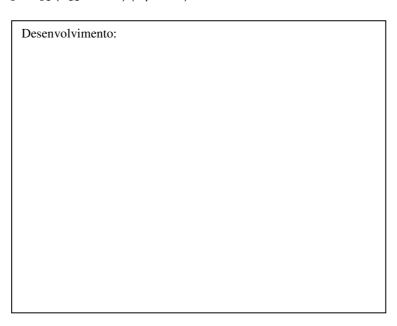
2) Para o circuito abaixo, calcule o valor de I_D e V_{DS} (V_{GS} = -5V) (2 pontos)



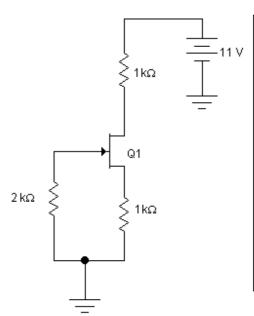
Desenvolvimento:		

3) Para o circuito abaixo, calcule o valor de I_D e V_{DS} (V_{GS} =-1.5V) (2 pontos)





4) Para o circuito abaixo, calcule o valor de I_D e V_{DS} (ID_{SS} = 4mA e V_P =-4V) (2 pontos) Dica: Lembre-se que o valor de VGS deve estar entre -4V e 0V



Desenvolvimento: $ID = IDSS (1 - V_{GS})^2$

5) Explique o funcionamento do MOSFET de intensificação, citando a diferença deste para o MOSFET de depleção entre ambos: (2 pontos)

Diagrama e explicações: